**Мазалов, Александр Владимирович. Гетероструктуры (Al)GaN/AlN для полупроводниковой фотоэлектроники ближнего УФ-диапазона : диссертация ... кандидата технических наук : 05.11.07 / Мазалов Александр Владимирович; [Место защиты: Науч.-исслед. ин-т "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха].- Москва, 2013.- 110 с.: ил. РГБ ОД, 61 14-5/58**